**第四届全国宽禁带半导体学术会议（三号黑体）**

作者1，作者2，作者3（四号宋体）

1 单位名称，单位地址，邮编

\*通讯作者：电话/传真： 邮箱：xxx@xmu.edu.cn

(地址和单位栏使用五号宋体)

**正文要求：**

本模板为第四届全国宽禁带半导体学术会议征文的格式要求。中英文撰写皆可。中文使用五号宋体，英文采用五号Times New Roman，参考文献字体同正文。

页面设置为A4纸，页边距（上下左右）均为2.54厘米。整个摘要尽量不超过1页A4版面。

近年来，宽禁带半导体已成为全球高技术领域竞争战略制高点之一，国际半导体及材料领域研究和发展的热点，基于宽禁带半导体材料，半导体照明已经形成巨大规模的产业，并在电子功率器件领域继续深入发展。为推动我国宽禁带半导体领域的发展，加强各界交流与协同创新，2015年10月，中国电子学会电子材料学分会发起并主办了首届全国宽禁带半导体学术会议，会议由中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所承办。自第二届开始，会议更新为由中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会、中国电子学会电子材料学分会两家单位共同主办。广东省半导体产业技术研究院、第三代半导体产业技术创新战略联盟共同承办了第二届大会。

随着大会规模和影响力不断增强，今年，“全国宽禁带半导体学术会议”迎来了第四届，定于2021年10月12-15日在美丽的鹭岛厦门举办，中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会、中国电子学会电子材料学分会共同主办，厦门大学和第三代半导体产业技术创新战略联盟联合承办。

届时，来自国内宽禁带半导体领域学术界、产业界的专家学者、科研技术人员、院校师生、企业家代表等，将围绕宽禁带半导体材料生长技术、材料结构与物性、光电子和电子器件研发以及相关设备研发等领域开展广泛交流，促进产学研用的交流合作。深信这次会议必将对我国宽禁带半导体材料与器件的学术研究、技术进步、产业发展起到有力的推动作用。

**参考文献：**

[1] M. F. Wang, T. W. Zhao and S. H. Mill, Appl. Phys. Lett.,vol.97, pp. 58-72, 2008.(示例)